

**Сведения о ведущей организации**  
 по диссертации Сиделева Алексея Владимировича  
 на тему «Разработка детекторов поглощенной дозы ионизирующего излучения  
 с чувствительными элементами на основе р-канальных  
 МНОП-транзисторов», представленной на соискание ученой степени кандидата  
 технических наук по специальности 2.2.2. Электронная компонентная база  
 микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пульсар», г. Москва
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	АО «НПП «Пульсар»
Ведомственная принадлежность	Минпромторг России
Тип организации	Акционерное общество
Почтовый индекс, адрес организации	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Веб-сайт	<a href="http://www.pulsarnpp.ru">www.pulsarnpp.ru</a>
Телефон	+7(495)365-12-30
Адрес электронной почты	<a href="mailto:administrator@pulsarnpp.ru">administrator@pulsarnpp.ru</a>

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. Методика TCAD-моделирования квантовой эффективности элементов фоточувствительных микросхем / А.М. Маклаков, И.А. Макарова, А.А. Пугачёв, Д.А. Фёдоров // Электронная техника. Серия 2: полупроводниковые приборы. – 2024. – № 3 (274), С. 51 – 54.

2. Расчётно-аналитическое прогнозирование стойкости кремниевых биполярных транзисторов к воздействию импульсного нейтронного излучения с учётом требований современной нормативно-технической документации / Э.Н. Вологдин, В.Ф. Синкевич, Д.С. Смирнов // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2024. – № 1(272), С. 3 – 13.

3. Расчётно-экспериментальная оценка показателей безотказности на этапе разработки ЭКБ на GaN космического применения / В.Ф. Синкевич, А.В. Телец, Б.М. Раппопорт // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2024. - № 2(273), С. 4 – 13.

4. Лавинно-инжекционная неустойчивость и лавинный пробой в широкозонных гетероструктурных полевых транзисторах / Я.Б. Мартынов, В.Ф. Синкевич // Электронная техника. Серия 1: СВЧ-техника. – 2023. – № 4(560), С. 6 – 18

5. Радиационная стойкость GaN СВЧ гетеротранзисторов / Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2023. – № 1(268), С. 4 – 11.

6. Влияние состава гетероструктуры на долговременную стабильность СВЧ генератора / М.В. Кулиев // Нано- и микросистемная техника. – 2022. –

Т. 24, № 1, С. 27 – 29.

7. TCAD- И SPICE-модели МОП-транзистора с ионно-легированным каналом для выходного устройства фоточувствительной ПЗС микросхемы / Д. Е. Звягинцев, А.А. Пугачёв, С.В. Соколов, И.А. Харитонов // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2022. – № 3(266), С. 15 – 30.

8. Влияние обработки в азотной плазме на электрические параметры гетероструктур AlGaIn/GaN / К.Л. Енишерлова, Л.А. Сейдман, С.Ю. Боголюбова // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. – 2022. – Т. 25, № 3, С. 227 – 237.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель Сиделев Алексей Владимирович не является ее сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

Заместитель генерального директ  
АО «НПП «Пульсар»

овский Юрий Владимирович